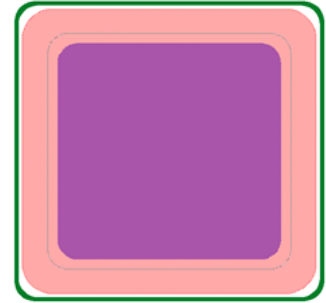


## 概述

- LM605ESDP4-0.21 是利用先进的硅电路工艺生产的单向低电容静电放电保护器件。
  - 低钳位电压;
  - 快速的响应速度;
  - 低漏电电流 (<500nA);
  - 适合于高速数据传输线的ESD保护;
- IEC6100-4-2(ESD); +/-30KV(空气放电); +/-30KV(接触放电)



## 芯片信息

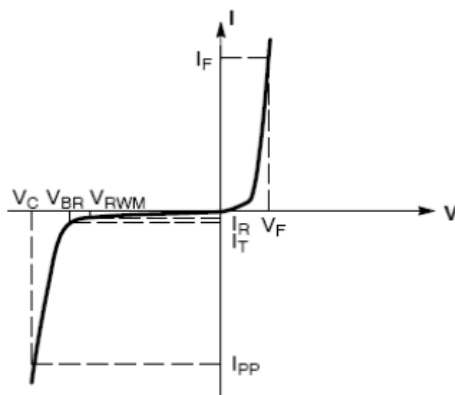
项目	描述
流片代码	KID006
圆片尺寸	6Inch
有效管芯数	350000dies wafer
芯片尺寸	210umx210um
压点尺寸	145umx145um
芯片厚度	150±10um
正面金属	Al:3um 或 Ag: 3um
背面金属	Ti/Ni/A 或 Ti/Ni/Sn/Ag
划片道宽度	50um

## 极限参数 (T<sub>amp</sub>=25°C)

参 数	符 号	额定值	单 位
芯片最高工作温度范围	T <sub>opr</sub>	-55 ~ +150	°C
芯片最高存储温度范围	T <sub>stg</sub>	-55 ~ +150	°C

## 电性参数 (T<sub>amp</sub>=25°C)

Symbol	Parameter
I <sub>PP</sub>	Maximum Reverse Peak Pulse Current
V <sub>C</sub>	Clamping Voltage @ I <sub>PP</sub>
V <sub>RWM</sub>	Working Peak Reverse Voltage
I <sub>R</sub>	Maximum Reverse Leakage Current @ V <sub>RWM</sub>
V <sub>BR</sub>	Breakdown Voltage @ I <sub>T</sub>
I <sub>T</sub>	Test Current
P <sub>pk</sub>	Peak Power Dissipation
C	Capacitance @ V <sub>R</sub> = 0 and f = 1.0 MHz



Item	Symbol	Test Conditions	Criterion			Unit
			Min	Typ	Max	
正向压降	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =10mA			1.1	V
最大峰值功率	P <sub>PK</sub>	I <sub>pp</sub> =4A, t <sub>p</sub> =8/20us			80	W
维持电压	V <sub>RWM</sub>				5	V
击穿电压	V <sub>BR</sub>	I <sub>t</sub> =1mA	6		9	V
漏电流	I <sub>R</sub>	V <sub>RWM</sub> =±5V			0.5	uA
钳位电压	V <sub>C</sub>	I <sub>pp</sub> =1A, t <sub>p</sub> =8/20us			12	V
钳位电压	V <sub>C</sub>	I <sub>pp</sub> =4A, t <sub>p</sub> =8/20us			20	V
电容	C <sub>j</sub>	V <sub>R</sub> =0V, f=1Mz		0.7	1.0	pF

### 注意事项:

- 芯片存储条件 (推荐): 氮气保护, 温度 25±5°C, 湿度 ≤45%;
- 封装时, 请将距离圆片边沿 4mm 及以内位置的管芯剔除;

### NOTICE

Leiditech reserves the right to make modifications, enhancements, improvements, corrections or other changes without further notice to any product herein. Leiditech does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein.